

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
24. Juli 2003 (24.07.2003)

PCT

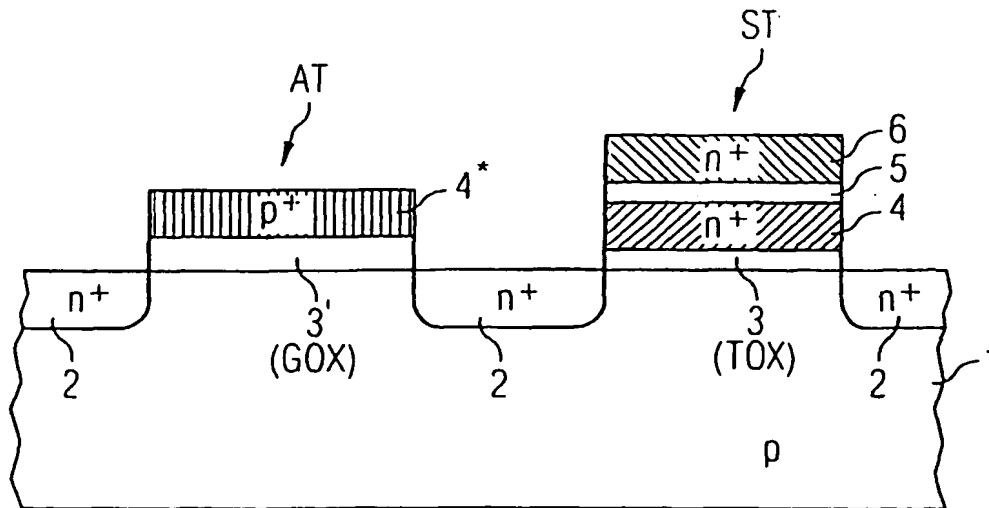
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 03/061011 A2**

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: H01L 27/115, 21/8246 (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St. Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE02/04521 (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHULER, Franz [DE/BE]; Lombaardenstraat 51, B-3000 Leuven (BE). TEMPEL, Georg [DE/BE]; Maurice Despretlaan 9, B-1933 Sterrebeek (BE).
- (22) Internationales Anmeldedatum: 10. Dezember 2002 (10.12.2002)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch (74) Anwalt: KINDERMANN, Peter; Postfach 1330, 85627 Grasbrunn (DE).
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, KR, US.
- (30) Angaben zur Priorität: 102 01 303.9 15. Januar 2002 (15.01.2002) DE

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: NON-VOLATILE TWO-TRANSISTOR SEMICONDUCTOR MEMORY CELL AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(54) Bezeichnung: NICHTFLÜCHTIGE ZWEITRANSISTOR-HALBLEITERSPEICHERZELLE SOWIE ZUGEHÖRIGES HERSTELLUNGSVERFAHREN



(57) Abstract: The invention relates to a non-volatile two-transistor semiconductor memory cell and to a method for producing the same. In a substrate (1), source and drain regions (2) for a selection transistor (AT) and a memory transistor (ST) are configured. Said memory transistor (ST) has a first insulating layer (3), a charge storage layer (4), a second insulating layer (5) and a memory transistor control layer (6). The selection transistor (AT) comprises a first insulating layer (3') and a selection transistor control layer (4\*). The use of different materials for the charge storage layer (4) and the selection transistor control layer (4\*) allows to substantially improve the charge maintaining properties of the memory cell while maintaining constant electrical properties by adapting the substrate doping.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 03/061011 A2



(84) **Bestimmungsstaaten** (*regional*): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR).

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

**Veröffentlicht:**

— *ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts*

---

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft eine nichtflüchtige Zweitransistor-Halbleiterspeicherzelle sowie ein zugehöriges Herstellungsverfahren, wobei in einem Substrat (1) Source- und Draingebiete (2) für einen Auswahltransistor (AT) und einen Speichertransistor (ST) ausgebildet sind. Der Speichertransistor (ST) weist eine erste Isolationsschicht (3), eine Ladungsspeicherschicht (4), eine zweite Isolationsschicht (5) und eine Speichertransistor-Steuerschicht (6) auf, während der Auswahltransistor (AT) eine erste Isolationsschicht (3') und eine Auswahltransistor-Steuerschicht (4\*) besitzt. Durch die Verwendung unterschiedlicher Materialien für die Ladungsspeicherschicht (4) und die Auswahltransistor-Steuerschicht (4\*) lassen sich die Ladungshalteeigenschaften der Speicherzelle durch Anpassung der Substratdotierung bei gleich bleibenden elektrischen Eigenschaften wesentlich verbessern.

## Beschreibung

Nichtflüchtige Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle sowie zugehöriges Herstellungsverfahren

5

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine nichtflüchtige Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle sowie ein zugehöriges Verfahren zu deren Herstellung und insbesondere auf eine nichtflüchtige Halbleiterspeicherzelle mit einem Speicher-

10

Figur 1 zeigt eine vereinfachte Schnittansicht einer derartigen herkömmlichen nichtflüchtigen Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle, wobei in einem Halbleitersubstrat 1, welches beispielsweise p<sup>-</sup>-dotiert ist, ein Auswahltransistor AT sowie ein Speichertransistor ST ausgebildet und über ein gemeinsames Source-/Draingebiet 2 miteinander verbunden sind.

15

Der Speichertransistor ST besteht üblicherweise aus einer isolierenden Tunneloxidschicht 3, einer leitenden Floating-Gate-Schicht 4, einer isolierenden dielektrischen Schicht 5 und einer leitenden Steuer-Gate-Schicht 6. Zur Speicherung von Informationen werden Ladungen vom Halbleitersubstrat 1 in die Floating-Gate-Schicht 4 eingebracht. Verfahren zum Einbringen der Ladungen in die Floating-Gate-Schicht 4 sind beispielsweise Injektion heißer Ladungsträger und Fowler-Nordheim-Tunneln.

20

25

Zum Auswählen bzw. Ansteuern des eigentlichen Speichertransistors ST besitzt die Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle ferner einen Auswahltransistor AT, der als Feldeffekttransistor im Wesentlichen eine Gateoxidschicht 3' und eine darüber liegende Steuer-Gate-Schicht 4 aufweist. Die Floating-Gate-Schicht des Speichertransistors und die Steuer-Gate-Schicht des Auswahltransistors bestehen üblicherweise aus dem gleichen Material wie z.B. Polysilizium, welches beispielsweise n<sup>+</sup>-dotiert ist.

30

35

Bei derartigen nichtflüchtigen Zweitransistor-Halbleiter-  
speicherzellen sind insbesondere die Ladungshalteeigenschaf-  
ten für den Einsatz und die Zuverlässigkeit von großer Bedeu-  
5 tung. Diese Ladungshalteeigenschaften sind üblicherweise  
durch (anormalen) Ladungsverlust begrenzt, der sich auf Grund  
von Leckphänomenen ergibt. Dieser Ladungsverlust geschieht  
beispielsweise auf Grund von Traps bzw. Störstellen innerhalb  
des Tunneloxids 3, wobei ein Tunnelmechanismus durch diese  
10 Störstellen bzw. Traps unterstützt wird (trap assisted tunne-  
ling). Zur Vermeidung von derartigen Leckströmen bzw. zur  
Verbesserung der Ladungshalteeigenschaften werden üblicher-  
weise die Schichtdicken für die Tunneloxidschicht 3 und/oder  
die dielektrische Schicht 5 erhöht, wodurch sich jedoch die  
15 elektrischen Eigenschaften der Speicherzelle verschlechtern  
und insbesondere die Betriebsspannungen zum Lesen, Schreiben  
und/oder Löschen der Speicherzelle angehoben werden müssen.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grunde eine nicht-  
20 flüchtige Zweitransistor-Halbleiterspeicherzelle sowie ein  
zugehöriges Herstellungsverfahren zu schaffen, welches ver-  
besserte Ladungshalteeigenschaften aufweist.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe hinsichtlich der Speicher-  
25 zelle durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 und hinsicht-  
lich des Verfahrens durch die Maßnahmen des Patentanspruchs 8  
gelöst.

Insbesondere durch die unterschiedliche Beschaffenheit der  
30 Ladungsspeicherschicht im Speichertransistor und der Auswahl-  
transistor-Steuerschicht im Auswahltransistor zur unabhängi-  
gen Optimierung der zugehörigen Schwellwertspannungen, kann  
ohne Verschlechterung der elektrischen Eigenschaften der  
Speicherzelle eine Verbesserung der Ladungshalteeigenschaften  
35 im Speichertransistor realisiert werden.

Vorzugsweise weisen die Auswahltransistor-Steuerschicht (4\*) und die Ladungsspeicherschicht (4) ein unterschiedliches Material oder insbesondere bei gleichem Halbleitermaterial eine unterschiedliche Dotierung auf. Auf diese Weise kann im Speichertransistor gezielt eine Feldverringering und damit eine Verbesserung der Ladungshaltung bewirkt werden, während der Auswahltransistor eine im Wesentlichen unveränderte Einsatzspannung bzw. Schwellwertspannung aufweist.

10 Vorzugsweise wird ein Halbleitersubstrat mit erhöhter Dotierung verwendet, wobei die Auswahltransistor-Steuerschicht und die Ladungsspeicherschicht ein Halbleitermaterial mit unterschiedlicher Dotierung aufweisen. Dadurch können die elektrischen Felder im Speichertransistor und damit ein auf (z.B. durch Störstellen (traps) verursachtes) Tunneln basierender Leckstrom verringert werden, da dieser Tunnelstrom exponentiell abhängig vom elektrischen Feld ist. Andererseits wird die sich daraus ergebende Einsatzspannungsverschiebung durch eine Anpassung der Austrittsarbeiten in der Auswahltransistor-Steuerschicht durch eine entgegengesetzte Dotierung kompensiert, wodurch die absolute Schwellwertspannung des Auswahltransistors AT reduziert wird und damit der Lesestrom durch die gesamte Zelle erhöht wird. Dies wiederum erlaubt einfachere Auswerteschaltungen auf dem Chip.

25 Alternativ zur Erhöhung der Dotierstoffkonzentration im Substrat kann auch lediglich oder zusätzlich das Kanalgebiet bzw. eine Oberfläche des Substrats stärker dotiert werden. Ferner kann alternativ zur gesamten Dotierung des Substrats oder zur Oberflächendotierung auch eine erhöhte Wannendotierung zur Modifikation der Schwellwertspannung verwendet werden.

35 Hinsichtlich des Verfahrens werden vorzugsweise sowohl für den Auswahltransistor als auch den Speichertransistor eine erste Isolationsschicht, eine elektrisch leitende Halbleiterschicht, eine zweite Isolationsschicht und eine weitere

elektrisch leitende Schicht ausgebildet und derart strukturiert, dass sich die beiden Transistoren mit dazwischen liegenden Source- und Draingebieten im Halbleitersubstrat ergeben. Lediglich für die elektrisch leitende Halbleiterschicht des Auswahltransistors ist hierbei eine entgegengesetzte Dotierung alternativ oder zusätzlich anzuwenden, um die Schwellwertspannung zu verringern. Auf diese Weise kann eine nichtflüchtige Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle mit verbesserten Ladungshalteeigenschaften besonders kostengünstig hergestellt werden.

In den weiteren Unteransprüchen sind weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung gekennzeichnet.

Die Erfindung wird nachstehend anhand eines Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher beschrieben.

Es zeigen:

Figur 1 eine vereinfachte Schnittansicht einer herkömmlichen nichtflüchtigen Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle;

Figur 2 eine vereinfachte Schnittansicht einer erfindungsgemäßen nichtflüchtigen Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle;

Figuren 3A bis 3D vereinfachte Schnittansichten zur Veranschaulichung wesentlicher Herstellungsschritte der erfindungsgemäßen nichtflüchtigen Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle;

Figur 4a und 4B vereinfachte graphische Darstellungen zur Veranschaulichung einer Abhängigkeit der Schwellwertspannungen von der Zeit aufgrund von Ladungsverlusten; und

Figuren 5A bis 5C vereinfachte graphische Darstellungen zur Veranschaulichung der Auswirkungen einer Änderung der Aus-

trittsarbeit auf die Schwellwertspannungen im Auswahltransistor und Speichertransistor.

Figur 2 zeigt eine vereinfachte Schnittansicht einer nicht-flüchtigen Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle gemäß der vorliegenden Erfindung, wobei gleiche Bezugszeichen gleiche oder ähnliche Schichten bezeichnen wie in Figur 1.

Gemäß Figur 2 wird in einem Substrat 1, welches beispielsweise aus einem p-dotierten Silizium-Halbleitermaterial besteht, ein Auswahltransistor AT und ein Speichertransistor ST ausgebildet, welche über ein gemeinsames Source-/Draingebiet 2 miteinander verbunden sind. Der Speichertransistor ST besitzt eine erste Speichertransistor-Isolationsschicht 3, die vorzugsweise eine Tunneloxidschicht TOX aufweist und ca. 10 nm dick ist. An der Oberfläche dieser ersten Speichertransistor-Isolationsschicht 3, die beispielsweise aus einer thermisch ausgebildeten SiO<sub>2</sub>-Schicht besteht befindet sich eine Ladungsspeicherschicht 4, die beispielsweise eine n<sup>+</sup>-dotierte Polysiliziumschicht aufweist. Darüber liegend ist eine zweite Speichertransistor-Isolationsschicht 5 angeordnet, die die Ladungsspeicherschicht 4 von einer darüber angeordneten Speichertransistor-Steuerschicht 6 isoliert. Die Speichertransistor-Steuerschicht 6 kann ebenfalls beispielsweise n<sup>+</sup>-dotiertes Polysilizium aufweisen und stellt im Wesentlichen eine Wortleitung der Speicherzelle dar. Die zweite Speichertransistor-Isolationsschicht 5 wird auch als Interpoly-Dielektrikum bezeichnet und kann beispielsweise eine ONO-Schichtenfolge (Oxid-Nitrid-Oxid) aufweisen.

30

Der Auswahltransistor AT besteht seinerseits aus einer an der Oberfläche des Substrats 1 bzw. zwischen den Source- und Draingebieten 2 liegenden Kanalgebiets ersten Auswahltransistor-Isolationsschicht 3' und einer Auswahltransistor-Steuerschicht 4\*. Die Auswahltransistor-Isolationsschicht 3' besteht vorzugsweise aus einer Gateoxidschicht GOX. Die Auswahltransistor-Steuerschicht 4\* besteht ebenfalls aus einer

35

## 6

elektrisch leitenden Schicht und beispielsweise aus einer  $p^+$ -dotierten Polysiliziumschicht.

Der wesentliche Unterschied der erfindungsgemäßen Speicherzelle ergibt sich nunmehr aus der modifizierten Dotierung des Substrates und der sich daraus ergebenden modifizierten natürlichen Einsatzspannungen in Kombination mit der Wahl unterschiedlicher Materialien bzw. unterschiedlicher Dotierungen fuer die Ladungsspeicherschicht 4 und die Auswahltransistor-Steuerschicht 4\*. Auf Grund einer erhöhten Dotierung des Substrats 1 von  $p^-$  beispielsweise auf  $p$  oder  $p^+$  bei gleichbleibenden Dotierungen für die Ladungsspeicherschicht 4 und die Speichertransistor-Steuerschicht 6 erhält man eine erhöhte Schwellwertspannung des Speichertransistors ST. Wie später im Einzelnen beschrieben wird, ergibt sich durch diese Anpassung der Schwellenwertspannung im Speichertransistor ST die Möglichkeit, die Ladungshalteeigenschaften zu optimieren. Andererseits erhält man im Auswahltransistor AT eine Verringerung der Schwellwertspannung durch eine zur Ladungsspeicherschicht 4 entgegengesetzte Dotierung. Genauer gesagt wird durch die  $p^+$ -Dotierung der Auswahltransistor-Steuerschicht 4\* die Erhöhung dessen Schwellwertspannung kompensiert, wodurch sich im Wesentlichen eine erniedrigte Schwellwertspannung im Auswahltransistor ergibt und somit eine nicht dargestellte Auswerteschaltung zum Auswerten der Speicherzelle einfacher verwirklicht werden kann.

Wesentlich für das vorliegende Konzept ist demnach, dass im Speichertransistor ST die Schwellwertspannung ueber die Substrat-, Wannen- und/oder Kanaldotierung bzgl. Ladungshaltung optimiert werden kann und dass die sich dadurch fuer den Auswahltransistor ergebenden Nachteile durch eine der Ladungsspeicherschicht entgegengesetzten Dotierung kompensiert werden können. Dadurch können die für das Tunneln verantwortlichen elektrischen Felder im Speichertransistor verringert werden, wodurch sich eine verbesserte Ladungshalteeigenschaft ergibt, wobei hinsichtlich einer Außenbeschaltung die elekt-



rischen Eigenschaften der Zelle unverändert bleiben, da im Auswahltransistor AT diese Schwellwertverschiebung wieder kompensiert wird.

- 5 Obwohl vorstehend ein gleiches Material (Polysilizium) mit unterschiedlicher Beschaffenheit (Dotierung) verwendet wurde, erhält man den gleichen Effekt auch bei Einsatz von unterschiedlichen Materialien (unterschiedliche Metalle, Halbleiter usw.) für die Ladungsspeicherschicht 4 und die Auswahltransistor-Steuerschicht 4\*.
- 10

Eine genaue Erläuterung der vorstehend beschriebenen Zusammenhänge erfolgt nachstehend, wobei jedoch zunächst ein mögliches Verfahren zur Herstellung einer derartigen nichtflüchtigen Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle beschrieben wird.

15

Figuren 3A bis 3D zeigen vereinfachte Schnittansichten zur Veranschaulichung wesentlicher Herstellungsschritte der erfindungsgemäßen nichtflüchtigen Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle, wobei gleiche Bezugszeichen gleiche oder ähnliche Schichten bezeichnen und auf eine wiederholte Beschreibung nachfolgend verzichtet wird.

20

- 25 Gemäß Figur 3A wird zunächst auf einem Substrat 1, welches beispielsweise ein Silizium-Halbleitersubstrat mit einer erhöhten p-Dotierung aufweist eine erste Isolationsschicht 3 sowohl in einem Auswahltransistor-Bereich als auch in einem Speichertransistor-Bereich ausgebildet. Diese erste Isolationschicht 3 bzw. 3' besteht beispielsweise aus einem thermisch ausgebildeten Siliziumdioxid. Ein positiver Effekt einer ausreichend dicken ersten Isolationsschicht bzw. Gateoxidschicht 3' im Auswahltransistor-Bereich ist die Vermeidung einer Dotierstoff- beispielsweise Bor-Penetration in das Substrat 1, die sich aus einer nachfolgenden Dotierung ergeben kann.
- 30
- 35

Nachfolgend wird an der Oberfläche eine elektrisch leitende Halbleiterschicht 4 bzw. 4\* (z.B. Polysiliziumschicht) ausgebildet, wobei diese Schicht beispielsweise durch eine Maske im Bereich des Speichertransistors ST eine zur Dotierung des Substrats 1 entgegengesetzte Dotierung wie z.B. eine n<sup>+</sup>-Dotierung aufweist. Demgegenüber kann beispielsweise durch eine Maskierung die elektrisch leitende Halbleiterschicht 4\* mit einer zum Substrat 1 gleichen Dotierung vom ersten Leitungstyp dotiert werden wie z.B. einer p<sup>+</sup>-Dotierung. Auf diese Weise werden bereits die vorstehend beschriebenen Einsatzspannungen bzw. Schwellwertspannungen in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich eingestellt, wobei vorzugsweise eine Schwellwertspannung im Auswahltransistor-Bereich derart eingestellt ist, dass sich kein Unterschied zum Auswahltransistor einer herkömmlichen nichtflüchtigen Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle ergibt, wodurch z.B. bereits existierende Auswerteschaltungen bzw. -konzepte problemlos übernommen werden können.

Alternativ kann jedoch auch eine überlagerte Dotierung stattfinden, wobei beispielsweise zunächst eine n-dotierte elektrisch leitende Schicht sowohl für den Auswahltransistor-Bereich als auch für den Speichertransistor-Bereich (beispielsweise insitu dotiert) abgeschieden wird und anschließend für den Auswahltransistor-Bereich eine Gegendotierung beispielsweise mit einer maskierten Implantation erfolgt. Grundsätzlich kann die erste ganzflächige Dotierung auch durch eine ganzflächige Implantierung oder eine sonstige Dotierung durchgeführt werden.

Die Herstellung der verschieden dotierten Polyschichten 4 und 4\* erfolgt vorzugsweise mittels herkömmlicher Fototechnik und Implantation, wobei eine davon ganzflächig erfolgen kann und nur die zweite beispielsweise mittels Fototechnik maskiert wird. Somit erfolgt bei dieser Dotierung eine Überkompensation der ersten Dotierung. Für die p-Dotierung der elektrisch leitenden Halbleiterschicht 4\* im Auswahltransistor-Bereich

wird üblicherweise Bor verwendet, während für die n-Dotierung im Speichertransistor-Bereich üblicherweise eine Phosphor- oder Arsen-Dotierung durchgeführt wird.

- 5 Gemäß Figur 3B wird in einem nachfolgenden Schritt eine zweite Isolationsschicht 5 an der Oberfläche der elektrisch leitenden Halbleiterschicht 4 bzw. 4\* ausgebildet, wobei diese zumindest im Speichertransistor-Bereich ausgebildet werden muss. Diese zweite Isolationsschicht 5 wird üblicherweise als
- 10 Inter-Poly-Dielektrikum bezeichnet und kann beispielsweise eine ONO-Schichtenfolge aufweisen, wodurch sich besonders gute Isolationseigenschaften bei guter kapazitiver Ankopplung realisieren lassen und insbesondere Leckströme zu einer nachfolgend ausgebildeten weiteren elektrisch leitenden Schicht 6
- 15 verhindert werden. Die weitere elektrisch leitende Schicht 6 besteht beispielsweise wiederum aus einer n<sup>+</sup>-dotierten Polysiliziumschicht, die mit einem herkömmlichen Verfahren abgeschieden oder aufgewachst wird.
- 20 Abschließend wird eine Maskenschicht 7 an der Oberfläche von zumindest der weiteren elektrisch leitenden Schicht 6 im Speichertransistor-Bereich ST und der elektrisch leitenden Halbleiterschicht im Auswahltransistor-Bereich AT ausgebildet und strukturiert, wobei beispielsweise eine herkömmliche
- 25 Hartmaskenschicht verwendet werden kann.

- Gemäß Figur 3C wird nunmehr unter Verwendung der strukturierten Maskenschicht 7 zunächst die weitere elektrisch leitende Schicht 6 teilweise entfernt, wodurch man zunächst die Wort-
- 30 leitungen der Speichertransistoren ST und darüber hinaus durch weiteres Entfernen der Schichten bis zur elektrisch leitenden Halbleiterschicht 4 bzw. 4\* auch die Leitungen der Auswahlgates der Auswahltransistoren erhält. Zum Entfernen dieser Schichten 4 bzw. 4\*, 5 und 6 kann ein jeweils verfügbares Standardätzverfahren verwendet werden, wobei insbesondere anisotrope Ätzverfahren in Betracht kommen, die selektiv
- 35

10

zur ersten Isolationsschicht 3, 3' und zur Maskenschicht 7 wirken.

5 Gemäß Figur 3D wird in einem abschließenden Herstellungsschritt eine selbstjustierende Implantation I zur Realisierung der Source-/Draingebiete 2 durchgeführt, wobei zur Herstellung eines NMOS-Transistors eine  $n^+$ -Dotierung beispielsweise mittels Phosphor oder Arsen erfolgt. Weitere Herstellungsschritte zu Fertigstellung der Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle werden nachfolgend nicht beschrieben, da  
10 sie allgemein bekannt sind.

Die für den Auswahltransistor AT nicht benötigten Schichten 5, 6 und 7 bleiben hierbei unbeschaltet oder können in einem  
15 nachfolgenden Verfahrensschritt entfernt werden. Auf diese Weise erhält man eine nichtflüchtige Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle mit verbesserten Ladungshalteeigenschaften, die auf besonders einfache Art und Weise hergestellt werden kann.

20

Zur Veranschaulichung der Wirkungsweise der erfindungsgemäßen Speicherzelle werden anhand von Figuren 4A und 4B die Einflüsse einer Schwellwertspannung im Speichertransistor auf die Ladungshalteeigenschaften beschrieben.

25

Figur 4A zeigt eine graphische Darstellung der in einer Speicherzelle maßgeblichen Schwellwertspannungen und ihre zeitliche Abhängigkeit, wenn die Speicherzelle (anomale) Ladungsverlusteffekte zeigt.

30

Gemäß Figur 4A ist mit  $V_{th,uv}$  eine Einsatzspannung bzw. Schwellwertspannung des Speichertransistors ST in einem ungeladenen Zustand (z.B. nach einem UV-Löschen) dargestellt. Die Äste  $V_{th,st}$  zeigen die Schwellwertspannung des Speichertransistors ST im geladenen Zustand bzw. den transienten Verlauf der Einsatzspannung bis hin zum sogenannten ungeladenen Zustand, bei dem sich in der ladungsspeichernden Schicht 4 kei-

35

nerlei Ladungen befinden. Diese Entladung ergibt sich im Wesentlichen durch z.B. störstellenunterstütztes Tunneln (trap assisted tunneling) hervorgerufene Leckströme.

5 Mit  $V_{th,A}$  ist eine Schwellwertspannung einer üblicherweise notwendigen Auswerteschaltung für die Speicherzelle dargestellt, die mehr oder weniger hoch bzw. fein sein kann. Grundsätzlich gilt jedoch, dass eine zugehörige Auswerteschaltung besonders einfach und kostengünstig hergestellt  
10 werden kann, je höher diese Spannung  $V_{th,A}$  ist. Andererseits zeigt die Figur 4A, dass je höher diese Schwellwertspannung  $V_{th,A}$  ist, um so früher ein Zeitpunkt  $t_{max}$  erreicht wird, zu dem ein abgespeichertes Bit nur noch fehlerhaft von der Auswerteschaltung erkannt wird.

15 Mit der vorliegenden Erfindung erfolgt nunmehr eine Anhebung der Einsatzspannung  $V_{th,uv}$  des Speichertransistors ST im ungeladenen Zustand sowie seiner zugehörigen Entladekurven  $V_{th,st}$  durch beispielsweise die vorstehend beschriebene Erhöhung einer Substratdotierung, einer Kanalgebietdotierung, und/oder  
20 einer Wannendotierung. Als Ergebnis dieser Anhebung der Einsatzspannung  $V_{th,uv}$  erhält man die in Figur 4B dargestellte Idealkurve, wobei man eine verbesserte Ladungshalteeigenschaft erhält, da die Schwellwertspannung  $V_{th,A}$  der Auswerteschaltung mit der Schwellwertspannung  $V_{th,uv}$  des Speichertransistors zusammenfällt.

Figuren 5A bis 5C zeigen graphische Darstellungen zur weiteren Veranschaulichung der erfindungsgemäßen Schwellwertänderungen auf Grund der Änderungen der Substratdotierung bzw.  
30 der entgegengesetzten Gate-Dotierung des Auswahltransistors (unterschiedliche Beschaffenheit von Ladungsspeicherschicht und Auswahltransistor-Steuerschicht).

35 Figur 5A zeigt eine graphische Darstellung der Schwellwertspannungen  $V_{th}$  für einen Auswahltransistor AT und einen Speichertransistor ST, wobei sich auf Grund von Kopplungseffekten

der unterschiedlichen Isolationsschichten GOX und TOX sowie der Schicht 5 in den jeweiligen Bereichen bereits ein Unterschied der jeweiligen Schwellwertspannungen ergibt. Im Regelfall besitzt der im gleichen Substrat 1 ausgebildete Speichertransistor ST einen höheren Schwellwert  $V_{th}$  als der zugehörige Auswahltransistor AT.

Gemäß Figur 5B wird nunmehr die Wirkung der Erhöhung der Substratdotierung beschrieben, wobei durch die erhöhte Dotierung im Substrat 1, durch eine erhöhte Wannendotierung und/oder eine erhöhte Oberflächendotierung beide Schwellwertspannungen gleichermaßen angehoben werden. Auf diese Weise erhält man zwar bereits die in Figur 4B verbesserten Ladungshalteeigenschaften im Speichertransistor ST, jedoch sind die elektrischen Eigenschaften der Speicherzelle insbesondere auf Grund der erhöhten Schwellwertspannungen im Auswahltransistor wesentlich verschlechtert.

Gemäß Figur 5C erfolgt demzufolge eine Korrektur der Schwellwertanhebung im Auswahltransistor AT, die im Wesentlichen durch eine Erhöhung der Austrittsarbeit für Elektronen in der Steuerschicht beispielsweise durch eine entgegengesetzte p-Dotierung erfolgt. Durch diese Änderung der Austrittsarbeit lediglich im Auswahltransistor AT wird demzufolge die Schwellwertspannung  $V_{th}$  in diesem Bereich wieder zurückgedrückt, wodurch man eine dem Ausgangszustand ähnliche Schwellwertspannung und somit ähnlich gute elektrische Eigenschaften der Speicherzelle erhält. Auf diese Weise können die Ladungshalteeigenschaften in einer Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle ohne Beeinflussung der elektrischen Eigenschaften oder einer notwendigen Auswerteschaltung wesentlich verbessert werden.

Die Erfindung wurde vorstehend anhand einer NMOS-Speicherzelle beschrieben. Sie ist jedoch nicht darauf beschränkt und umfasst in gleicher Weise PMOS- oder eine Kombination von PMOS- und NMOS-Zellen bzw. Transistoren. In gleicher Weise

ist die Erfindung nicht auf Silizium-Halbleitermaterialien beschränkt, sondern umfasst alle weiteren Halbleitermaterialien, mit denen gezielt eine Schwellwertspannung zur Verbesserung der Ladungshalteeigenschaften verändert werden kann.

- 5 In gleicher Weise kann für die Ladungsspeicherschicht, die Speichertransistor-Steuerschicht und die Auswahltransistor-Steuerschicht nicht nur ein Halbleitermaterial verwendet werden, sondern in gleicher Weise ein alternatives Material wie z.B. Metalle.

## Patentansprüche

1. Nichtflüchtige Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle mit

5 einem Speichertransistor (ST) mit einer vorbestimmten Schwellwertspannung, der in einem Substrat (1) ein Source- und Draingebiet (2) mit einem dazwischen liegenden Kanalgebiet aufweist, wobei an der Oberfläche des Kanalgebiets eine erste Speichertransistor-Isolationsschicht (3), eine Ladungsspeicherschicht (4), eine zweite Speichertransistor-Isolationsschicht (5) und eine Speichertransistor-Steuerschicht (6) ausgebildet ist; und  
10 einem Auswahltransistor (AT) mit einer vorbestimmten Schwellwertspannung, der im Substrat (1) ein Source- und Draingebiet (2) mit einem dazwischen liegenden Kanalgebiet aufweist, wobei an der Oberfläche des Kanalgebiets eine erste Auswahltransistor-Isolationsschicht (3') und eine Auswahltransistor-Steuerschicht (4\*) ausgebildet ist,  
15 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass  
20 zur unabhängigen Optimierung der Schwellwertspannungen ( $V_{th}$ ) des Speichertransistors (ST) und des Auswahltransistors (AT) die Auswahltransistor-Steuerschicht (4\*) unterschiedlich zur Ladungsspeicherschicht (4) ausgebildet ist.

25 2. Nichtflüchtige Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle nach Patentanspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass  
die Auswahltransistor-Steuerschicht (4\*) und die Ladungsspeicherschicht (4) ein unterschiedliches Material und/oder eine  
30 unterschiedliche Dotierung aufweisen.

3. Nichtflüchtige Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle nach Patentanspruch 1 oder 2,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass  
35 das Substrat (1) ein Halbleitermaterial mit einer Dotierung vom ersten Leitungstyp (p),



die Auswahltransistor-Steuerschicht (4\*) ein Halbleitermaterial mit einer Dotierung vom ersten Leitungstyp (p), und die Ladungsspeicherschicht (4) ein Halbleitermaterial mit einer zum ersten Leitungstyp entgegengesetzten Dotierung vom zweiten Leitungstyp (n) aufweist.

4. Nichtflüchtige Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle nach einem der Patentansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine Erhöhung der Dotierstoffkonzentration vom ersten Leitungstyp (p) im Substrat (1), den Kanalgebieten oder einem Wannengebiet erfolgt.

5. Nichtflüchtige Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle nach einem der Patentansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Speichertransistor-Isolationsschicht (3) und die erste Auswahltransistor-Isolationsschicht (3') eine SiO<sub>2</sub>-Schicht aufweisen.

6. Nichtflüchtige Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle nach einem der Patentansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ladungsspeicherschicht (4) und die Auswahltransistor-Steuerschicht (4\*) eine Polysilizium-Schicht und/oder eine metallische Schicht aufweisen.

7. Nichtflüchtige Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle nach einem der Patentansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Speichertransistor (ST) und der Auswahltransistor (AT) einen NMOS- und/oder einen PMOS-Transistor darstellen.

8. Verfahren zur Herstellung einer nichtflüchtigen Zweittransistor-Halbleiterspeicherzelle mit den Schritten:  
a) Ausbilden einer ersten Isolationsschicht (3, 3') für einen Auswahltransistor (AT) und einen Speichertransistor (ST)

auf einem Halbleitersubstrat (1), das eine Dotierung vom ersten Leitungstyp (p) aufweist;

- b) Ausbilden einer Halbleiterschicht (4) an der Oberfläche der ersten Isolationsschicht (3, 3'), die in einem Bereich des Auswahltransistors (AT) eine Dotierung vom ersten Leitungstyp (p) und in einem Bereich des Speichertransistors (ST) eine zum ersten Leitungstyp entgegengesetzte Dotierung vom zweiten Leitungstyp (n) aufweist;
- c) Ausbilden einer zweiten Isolationsschicht (5) an der Oberfläche der elektrisch leitenden Halbleiterschicht (4) zumindest im Bereich des Speichertransistors (ST);
- d) Ausbilden einer weiteren elektrisch leitenden Schicht (6) an der Oberfläche der zweiten Isolationsschicht (5) zumindest im Bereich des Speichertransistors (ST);
- e) Ausbilden und Strukturieren einer Maskenschicht (7);
- f) Ausbilden von Schichtstapeln im Bereich des Auswahltransistors (AT) und des Speichertransistors (ST) unter Verwendung der strukturierten Maskenschicht (7); und
- g) Ausbilden von Source- und Draingebieten (2) mit einer Dotierung vom zweiten Leitungstyp (n) unter Verwendung der Schichtstapel als Maske.

9. Verfahren nach Patentanspruch 8,

- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass in Schritt a) ein Halbleitersubstrat (1) mit erhöhter Grunddotierung, Wannendotierung und/oder Oberflächendotierung vom ersten Leitungstyp (p) verwendet wird.

10. Verfahren nach einem der Patentansprüche 8 oder 9,

- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass in Schritt a) im Bereich des Speichertransistors (ST) eine Tunneloxidschicht (TOX) und im Bereich des Auswahltransistors (AT) eine Gateoxidschicht (GOX) ausgebildet wird.

11. Verfahren nach einem der Patentansprüche 9 bis 10,

- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass in Schritt b) eine Polysilizium-Schicht abgeschieden wird und die unter-

schiedliche Dotierung im Bereich des Auswahltransistors (AT) und des Speichertransistors (ST) durch eine maskierte Implantation erfolgt.

- 5 12. Verfahren nach einem der Patentansprüche 9 bis 11,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass in Schritt  
c) eine ONO-Schichtenfolge ausgebildet wird.
- 10 13. Verfahren nach einem der Patentansprüche 9 bis 12,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass in Schritt  
d) eine weitere Polysilizium-Schicht abgeschieden wird, die  
eine Dotierung vom zweiten Leitungstyp (n) aufweist.
- 15 14. Verfahren nach einem der Patentansprüche 9 bis 13,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass in Schritt  
e) eine Hartmaskenschicht ausgebildet wird.
- 20 15. Verfahren nach einem der Patentansprüche 9 bis 14,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass in Schritt  
f) ein anisotropes Ätzverfahren durchgeführt wird.
16. Verfahren nach einem der Patentansprüche 9 bis 15,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass in Schritt  
g) eine Ionenimplantation (I) durchgeführt wird.

FIG 1 Stand der Technik

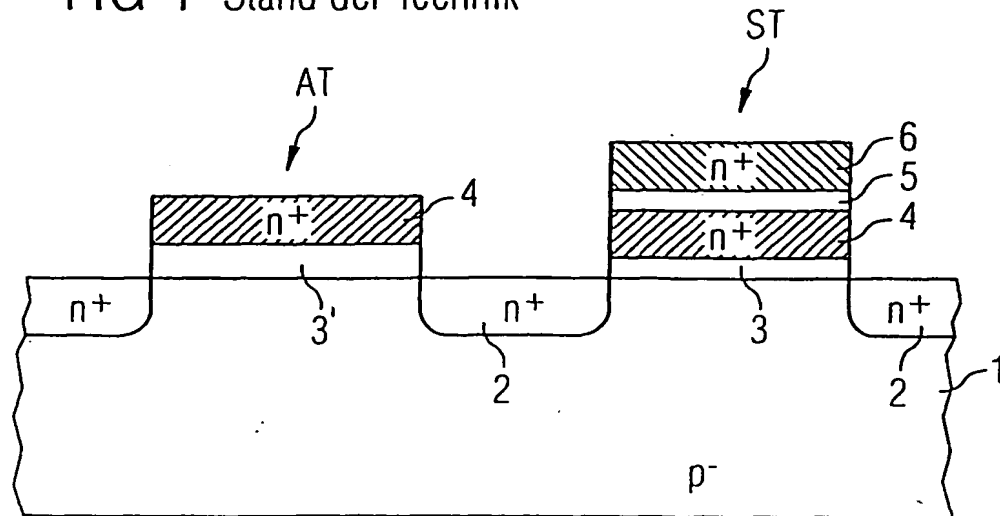


FIG 2

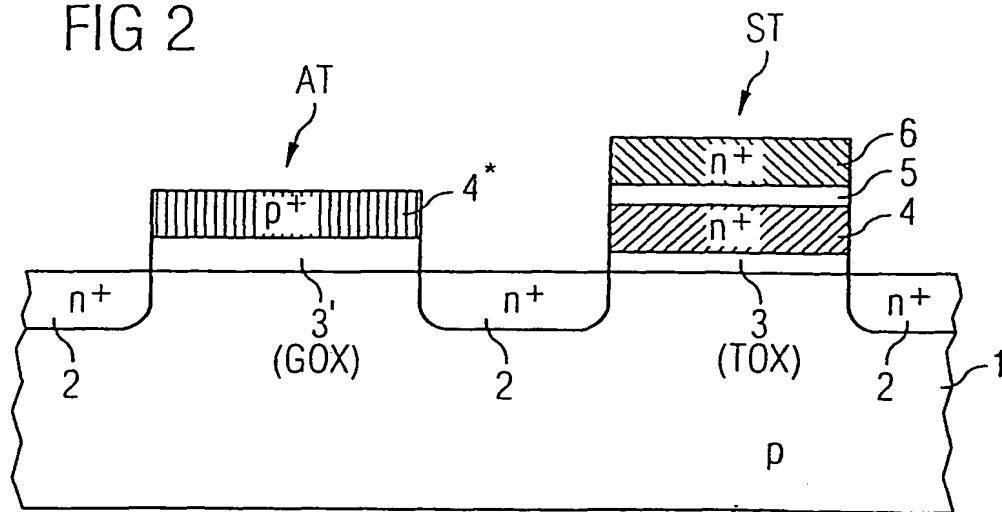


FIG 3A

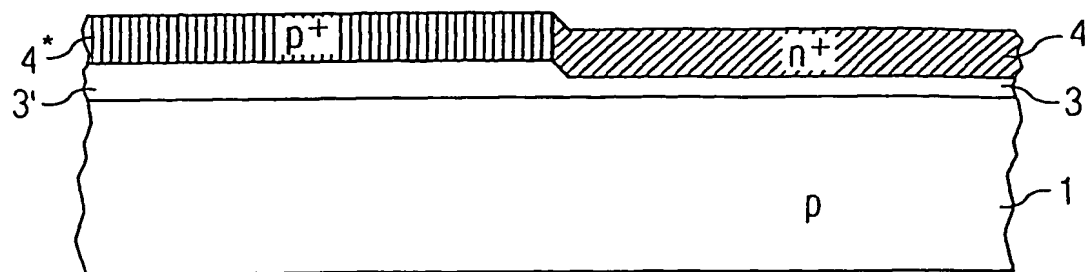


FIG 3B

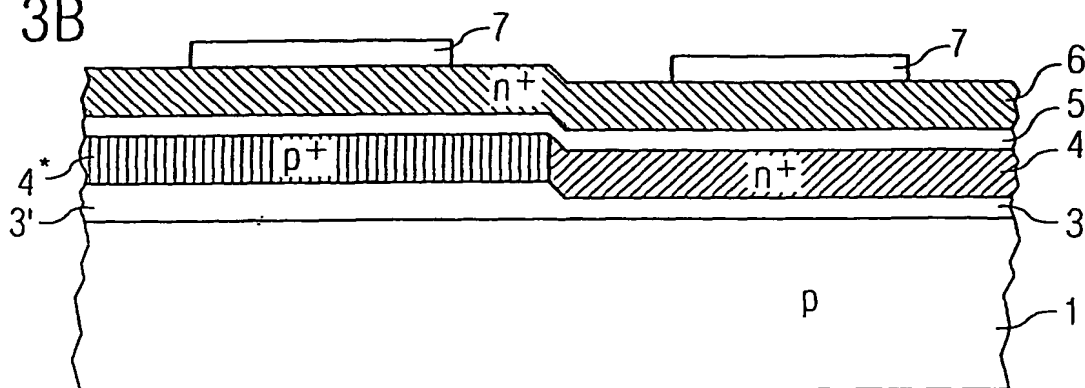


FIG 3C

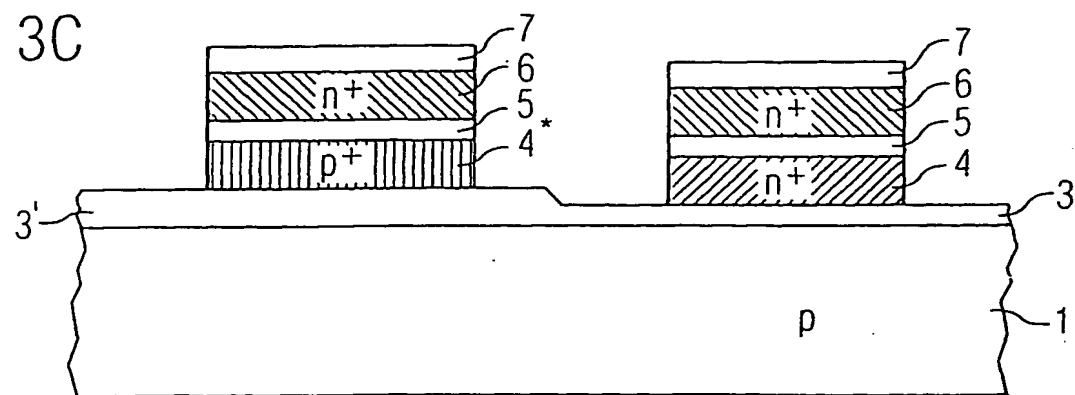


FIG 3D

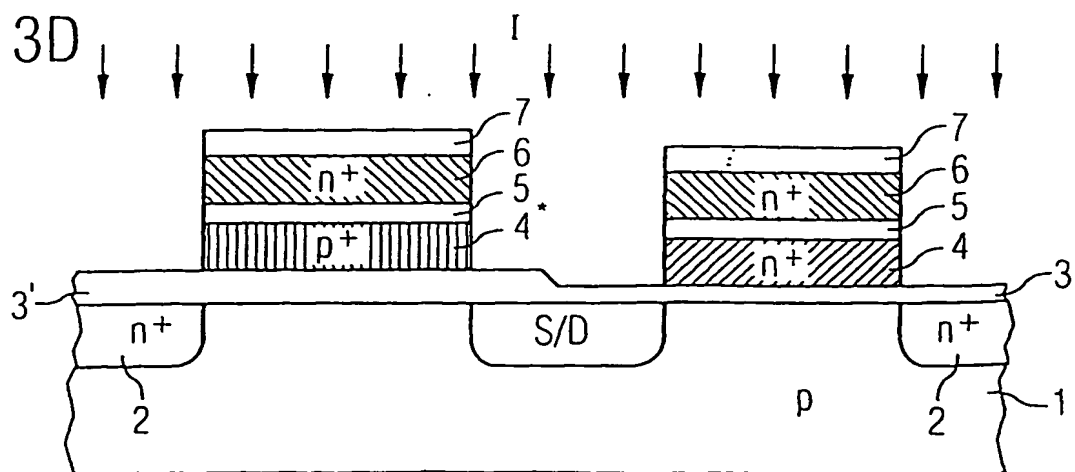


FIG 4A

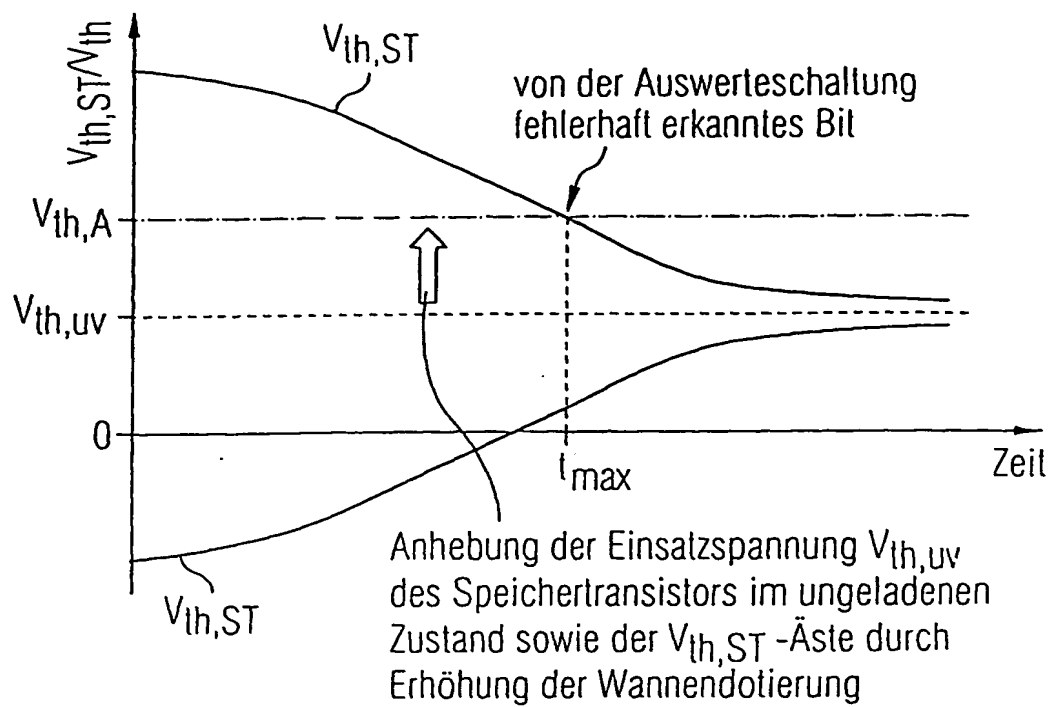


FIG 4B

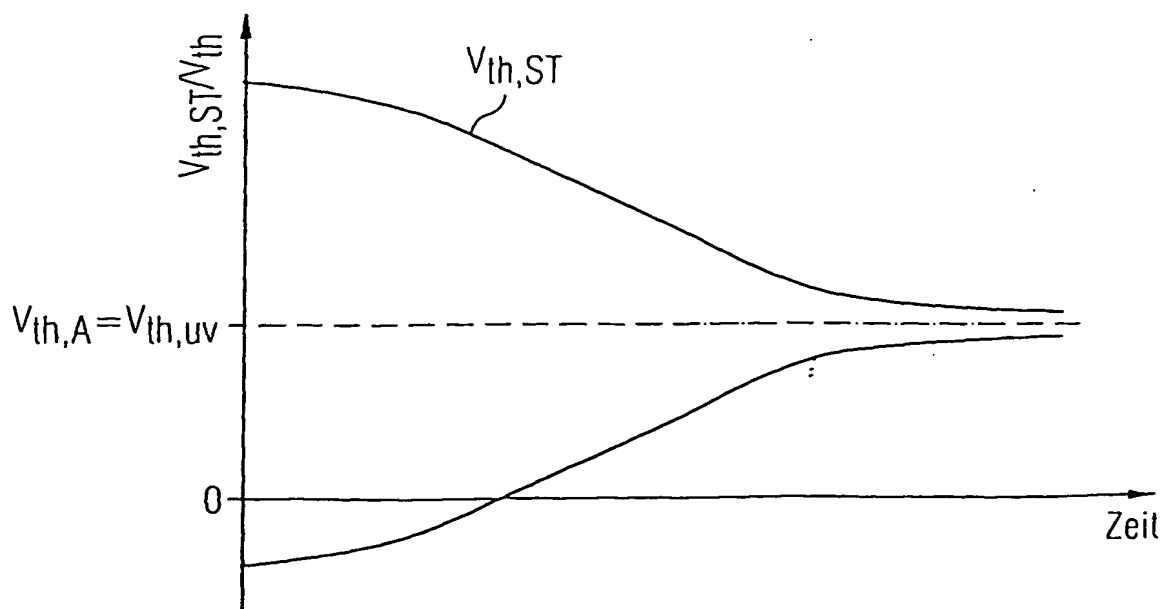


FIG 5A

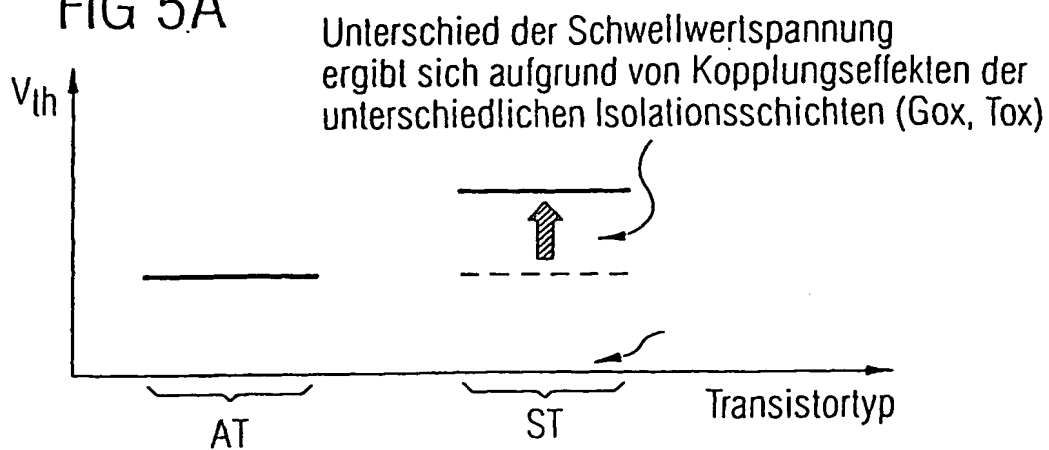


FIG 5B

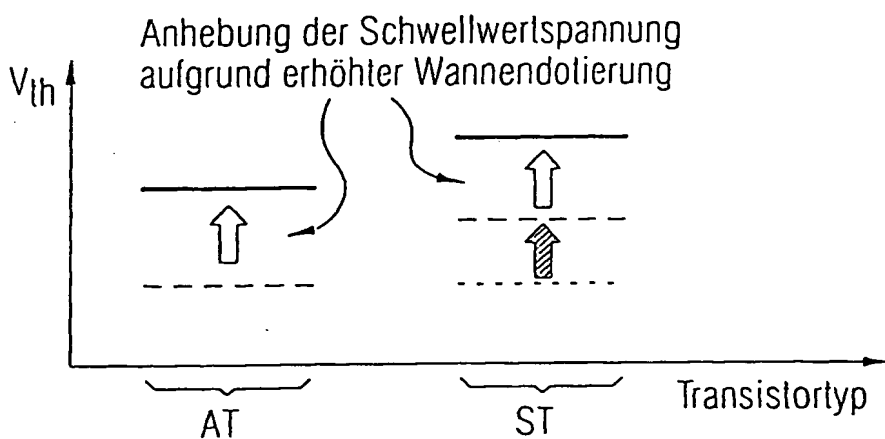


FIG 5C

